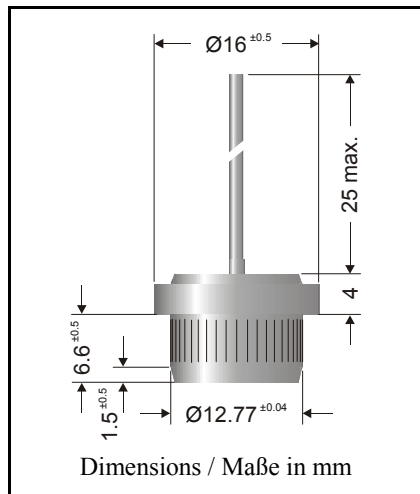


Silicon Press-Fit-Diodes

Silizium-Einpreßdioden



Nominal current – Nennstrom 35 A

Repetitive peak reverse voltage 50...600 V

Periodische Spitzensperrspannung

Metal press-fit case with glass seal

Metall-Einpreßgehäuse mit Glasdurchführung

Weight approx. 10 g

Gewicht ca.

Standard packaging: bulk

Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Wire to / Draht an	Periodische Spitzensperrspannung.	Stoßspitzensperrspannung
Anode Cathode	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
KYW 35A05 KYW 35K05	50	60
KYW 35A1 KYW 35K1	100	120
KYW 35A2 KYW 35K2	200	240
KYW 35A3 KYW 35K3	300	360
KYW 35A4 KYW 35K4	400	480
KYW 35A6 KYW 35K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 100^\circ\text{C}$ I_{FAV} 35 A
Dauerstrom in Einwegschaltung mit R-Last

Repetitive peak forward current $f > 15\text{ Hz}$ I_{FRM} 110 A ¹⁾
Periodischer Spitzenstrom

Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 360 / 400 A
Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwelle

Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 660 A²s
Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+175 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+175 °C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

¹⁾ Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 35\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\ \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	$< 0.8\text{ K/W}$

